

(11)Publication number:

2003-160859

(43) Date of publication of application: 06.06.2003

(51)Int.CI.

C23C 14/34 C22C 5/06

G11B 7/24 G11B 7/26

(21)Application number: 2001-358852

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

(22)Date of filing:

26.11.2001

(72)Inventor: MORI AKIRA

(54) SILVER ALLOY SPUTTERING TARGET FOR FORMING REFLECTION COAT ON OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silver alloy sputtering target for forming a reflection coat on an optical recording medium such as optical recording disks (CD-RW and DVD-RAM).

SOLUTION: The silver alloy sputtering target for forming the reflection coat on the optical recording medium comprises one or two of In and Sn in amounts of 0.5–15 mass% in total, further one or more of Cr, Co and Ni in amounts of 0.01–5 mass% in total, and the balance Ag. The reflection coat on the optical recording medium formed by sputtering the target hardly changes with time.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-160859 (P2003-160859A)

(43)公開日 平成15年6月6月(2003.6.6)

(51) Int.Cl.7		酸別記号	FI		5	r-7]-h*(参考)
C 2 3 C	14/34		C 2 3 C	14/34	Λ	4K029
C 2 2 C	5/06		C 2 2 C	5/06	Z	5 D O 2 9
G11B	7/24	5 3 8	G 1 1 B	7/24	538E	5 D 1 2 1
	7/26	5 3 1		7/26	531	

		審查請求	未請求 請求項の数2 〇L (全 4 頁)
(21)出願番号	特顧2001-358852(P2001-358852)	(71)出願人	
(22) 出顧日	平成13年11月26日(2001.11.26)	(max) resum to	三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号
		(72)発明者	兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マ
		(74)代理人	テリアル株式会社三田工場内 100076679
		Fターム(参	・ 弁理士 富田 和夫 (外1名) ・考) 4KO29 BA22 BCO7 BDO0 BD09 CA05
			DCO4 DCO8 5DO?9 MA13
			5D121 AA05 EE03 EE09 EE14

(54) 【発明の名称】 光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲット

(57)【要約】

【課題】 光記録ディスク(CD-RW, DVD-RAM)などの光記録媒体の反射膜を形成するための銀合金スパッタリングターゲットを提供する。

【解決手段】I nおよびS nの内の1種または2種を合計で0.5~15質量%を含み、さらにCr, Co, Niの内の1種または2種以上を合計で0.01~5質量%を含み、残部がAgである組成の銀合金からなる光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲット、およびそのターゲットをスパッタリングすることにより形成された経時変化の少ない光記録媒体の反射膜。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 【 n および S n の内の 1 種または 2 種を合 計で0.5~15質量%を含み、さらにCr, Co, N iの内の1種または2種以上を合計で0.01~5質量 %を含み、残部がAgである組成の銀合金からなること を特徴とする光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタ リングターゲット。

1

【請求項2】請求項1記載のターゲットをスパッタリン グすることにより形成された経時変化の少ない光記録媒 体の反射膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光記録ディスク (CD-RW, DVD-RAM) などの光記録媒体の反 射膜を形成するための銀合金スパッタリングターゲット に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、光記録ディスク(CD-RW, D VD-RAM) などの光記録媒体の反射膜としてAg反 射膜が使用されており、このAg反射膜は400~83 0 n mの幅広い波長域での反射率が高く、特に他の金属 の反射膜にくらべて、青色レーザー光などの短波長のレ ーザー光に対する反射率が優れているところから広く使 用されている。しかし、記録媒体が書き換え可能な相変 化形タイプの場合は、反射膜は記録媒体の線速に応じて 熱伝導率を容易に制御できることが必要であるが、Ag 反射膜は熱伝導率が良すぎるという欠点がある。したが って反射率が高くかつ熱伝導率の低い反射膜が求められ ており、その反射率が高くかつ熱伝導率の低い反射膜の 例としてAgにCu, Mg, Zn, Sn, Bi, In、 Ti、Zr、Au、Pd、Ptのうちの1種以上を含む Ag合金からなる反射膜が知られており(特開2001 -35014号公報参照)、さらにAg-In、Ag-V, Ag-Nbなどの合金からなる反射膜が知られてい る(特開平6-243509号公報参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これら従来の Ag合金反射膜は、いずれも表面の耐候性が不十分であ るところから、時間が経つにつれて反射率が低下し、特 に波長の短い青色レーザー光に対する反射率の低下が著 40 しく、短期間に光記録媒体の反射膜としての性能が低下 するという問題点があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】そこで本発明者らは、経 時変化の少ないAg合金反射膜を得るべく研究を行なっ ていたところ、(イ) In:0.5~15質量%を含 み、さらにCr, Co, Nio内の1種または2種以上 を合計で0.01~5質量%を含み、残部がAgである 組成の銀合金からなるターゲットを用いてスパッタリン グすることにより得られた銀合金反射膜は、経時変化に 50 を形成するためのスパッタリングターゲットに含まれる

よる反射率の低下が極めて少なくなる、(ロ)Agに含 まれるSnはІnと同じ作用を有するので、(イ)にお ける銀合金に含まれるInの一部または全部をSnで置 換することもできる、という研究結果が得られたのであ

【0005】この発明は、かかる研究結果に基づいて成 されたものであって、(1) InおよびSnの内の1種 または2種を合計で0.5~15質量%を含み、さらに Cr, Co, Niの内の1種または2種以上を合計で 10 0.01~5 質量%を含み、残部がAgである組成の銀 合金からなる光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタ リングターゲット、(2)前記(1)記載のターゲット をスパッタリングすることにより形成された経時変化の 少ない光記録媒体の反射膜、に特徴を有するものであ

【0006】この発明の銀合金反射膜を形成するための スパッタリングターゲットは、高純度Agを真空または 不活性ガス雰囲気中で溶解し、得られた溶湯にInおよ び/またはSnを添加してAg合金溶湯を作製し、この 20 Ag合金溶湯に、予め作製しておいたCr-Ag母合 金、Со-Ав母合金、Ni-Ав母合金を添加して所 定の成分組成のAg合金となるように真空または不活性 ガス雰囲気中で溶解し、このようにして得られた溶湯を 真空または不活性ガス雰囲気中で鋳造してインゴットを 作製し、得られたインゴットを熱間加工したのち機械加 工することにより製造することができる。

【0007】次に、この発明のAg合金からなるスパッ タリングターゲットおよびこのターゲットを用いて形成 したAg合金反射膜の成分組成を前記の如く限定した理 由を説明する。

【0008】 In, Sn: これら成分は、Ag合金反射 膜の反射率が経時変化するのを防止する効果があるが、 これら成分が0.5質量%未満含んでも十分な耐候性が 得られず、一方、15質量%を越えて含有すると、Ag合 金反射膜の初期反射率が低下するようになるので好まし くない。したがって、Ag合金反射膜およびこのAg合 金反射膜を形成するためのスパッタリングターゲットに 含まれるこれら成分の含有量は0.5~15質量%(一層 好ましくは5~10質量%)に定めた。

【0009】Cr、Co、Ni: これら成分は、Inお よびSnの内の1種または2種を合計で0.5~15質 量%を含むAg合金反射膜の耐候性を一層強化して反射 率が経時変化するのを防止する成分であるが、これら成 分の1種または2種以上を合計で0.01質量%未満含 んでも一層の耐候性が得られず、一方、これら成分の1種 または2種以上を合計で5質量%を越えて含有すると、 耐候性は一層優れたものとなるものの、Ag合金反射膜 の初期反射率が低下するようになるので好ましくない。 したがって、Ag合金反射膜およびこのAg合金反射膜

これら成分の含有量は0.01~5質量%(一層好ましく は0.5~3質量%)に定めた。

[0010]

【発明の実施の形態】原料として、Ag、In、Snを Ar雰囲気にて高周波誘導加熱炉により溶解し、得られ た溶湯に予めプラズマアーク溶解炉を使用して作製して おいたCr-Ag母合金、Co-Ag母合金、Ni-A g 母合金を添加して A g 合金溶湯を作製し、これら A g 合金溶湯をAr雰囲気中で鋳造することにより直径:1 作製した。このインゴットを輪切り状に切断して直径: 100mm、厚さ:30mmの寸法を有する円板を作製 し、さらにこの円板を600℃にて熱間圧延することに より厚さ:6mmの寸法を有する圧延板を作製し、これ を機械加工することにより直径:200mm、厚さ:5 mmの寸法を有し表1~2に示される成分組成を有する 本発明銀合金スパッタリングターゲット(以下、本発明 ターゲットという) 1~23、比較銀合金スパッタリン グターゲット(以下、比較ターゲットという)1~6お よび従来銀合金スパッタリングターゲット(以下、従来 20 ターゲットという)を作製した。

*【0011】この様にして得られた本発明ターゲット1 ~23、比較ターゲット1~6および従来ターゲットを それぞれ厚さ:10mmの無酸素銅製冷却板にIn-S n共晶はんだを用いてはんだ付けしたのち、通常の直流 マグネトロンスパッタリング装置に取り付け、さらに直 径:120mm、厚さ:1.2mmの寸法を有するポリ カーボネート樹脂板をターゲットと基板の距離が7 cm となるようにセットし、チャンバー内を1×10-1Pa まで真空に引いた後、アルゴンガスをチャンバー内に 00mm、長さ:90mmの寸法を有するインゴットを 10 0.5Paになるまで入れ、直流電力:100Wの条件 で40秒間スパッタリングし、膜厚:100nmの反射 膜を形成した。

> 【0012】これら反射膜に、波長が405nmおよび 650nmのレーザー光を照射してエリブソメータによ り反射率を測定し、その後反射膜を恒温恒湿槽容器(80 ℃、85%)に200時間保持した後、同様にして波長が 405nmおよび650nmのレーザー光を照射してエ リプソメータにより反射率を測定し、その結果を表1~ 2に示すことにより反射膜の耐候性を評価した。

[0013]

【表1】

種別		成分組成(質量%)						被長:405nmのレーザー光照射による反射膜の反射率(%)		放長:650nm のレーザー光照 射による反射膜の反射率(%)	
		Ιn	Sn	Сг	Co	Νi	Ag	成膜直後	200時間経過後	成膜直後	200時間経過後
	1	0.5		2	-		残部	90	85	95	89
	2	3	-		3		残部	92	80	98	87
	3	7		-		1	残部	89	80	95	90
	4	10		0.1			残部	83	79	94	89
	5	15	·	-	0.1	-	残部	85	78	98	87
本発明ターゲ	6		0.5	4	-	-	残部	91	79	97	86
	7	•	3	•	8	•	残部	92	80	97	92
	8	•	7	-	-	2	残部	90	81	96	88
	9	-	10	1			残部	89	79	95	88
ット	10	-	15	-	-	0.5	残部	87	80	98	91
L	11	0.5	7	1		-	残部	85	77	95	90
	12	3	5	-	2		残部	83	78	94	87
	13	7	3			3	残部	90	80	93	86
	14	8	2	-	1	1	残部	90	81	95	88
	15	10	1	0.8	0.6		残郁	90	80	96	80

[0014]

【表2】

種別			成	分组成	(質量:	٤)			のレーザー光照射 の反射率(%)	波長:650nm のレーザー光照 射による反射膜の反射率(%)		
		Ιn	Sn	Сr	Со	ΝI	Ag	成製直後	200時間経過後	成膜直後	200時問経過後	
本発明	16	6	•	0.6	0.5	0.5	残部	90	79	95	89	
	17	•	7	3	1	1	残部	88	80	94	89	
	18	-	5		2	1	残部	90	81	96	87	
タ	19		6	0.3		1	残部	90	82	94	88	
<u> </u>	20	9	•	0.3	1		残部	89	78	96	92	
ゲット	21	0.5		•	0.5	3	残部	88	80	94	89	
	22	8	•	2		0.5	残部	90	81	95	88	
	23	7	3	0.5		0.4	残部	90	80	92	89	
比較	1	•	0.4*	•		•	残部	90	51	95	65	
	2	0.4*		-			残部	91	50	97	65	
	3	-	7	_*	.*	-*	残部	85	60	94	78	
	4	7		.*	-*	.*	残部	85	59	96	77	
	5	18*	•	1	-	-	残部	70	65	85	70	
	6	7	-	6*	-		残部	70	65	88	79	
従来		-	-	-	-	-	100	90	55	98	75	

*印はこの発明の範囲から外れていることを示す。

【0015】表1~2に示される結果から、この発明の 本発明ターゲット1~23を用いてスパッタリングを行 20 反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲットを用いて うことにより得られた反射膜は、比較ターゲット1~6 および従来ターゲットを用いてスパッタリングを行うこ とにより得られた反射膜に比べて反射率の低下が少ない ところから、耐候性に優れていることがわかる。 [0016]

【発明の効果】上述のように、この発明の光記録媒体の 作製した反射膜は、従来の光記録媒体の反射膜形成用銀 合金スパッタリングターゲットを用いて作製した反射膜 に比べて、経時変化による反射率の低下が少なく、長期に わたって使用できる光記録媒体を製造することができ、 メディア産業の発展に大いに貢献し得るものである。